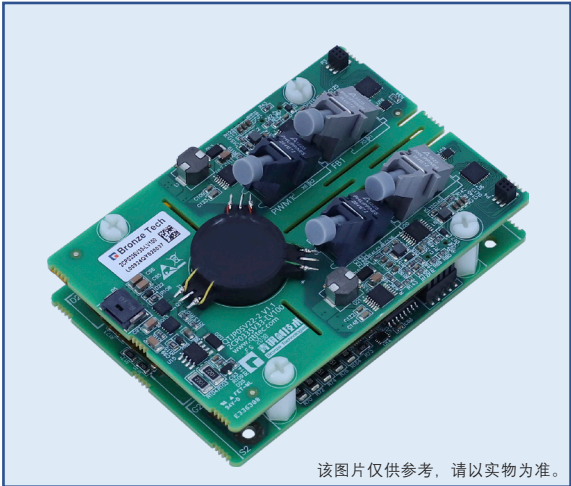


2CP0335V33-LV100 驱动器



该图片仅供参考，请以实物为准。

特征

- 2 通道 IGBT 驱动器
- 设计紧凑，尺寸为 68mm*99.5mm
- 电源电压输入宽范围 15V~30V
- 适配 LV100 封装的 SiC 模块
- 光纤信号输入 / 输出
- 集成副边电源欠压保护
- 集成 SiC 短路保护
- 集成短路电压尖峰抑制
- 集成米勒钳位
- 绝缘电压高达 8000V

RoHS
COMPLIANT

主要参数

V_{CC}	15V
V_G	+17V, -5V
P, MAX	3W
I_G , MAX	$\pm 25A$
f_s , MAX	20kHz
T_A	-40°C ~85°C
绝缘耐压	8000Vac

描述

2CP0335V33-LV100 是一款适配 SiC 模块的紧凑型 2 通道高绝缘等级的驱动器，针对高可靠性的大功率中压领域设计而成。

2CP0335V33-LV100 适用于三菱 3300V 的 LV100 封装 SiC 模块搭建的多种拓扑方案，可直接安装在模块上使用，无需要转接处理。

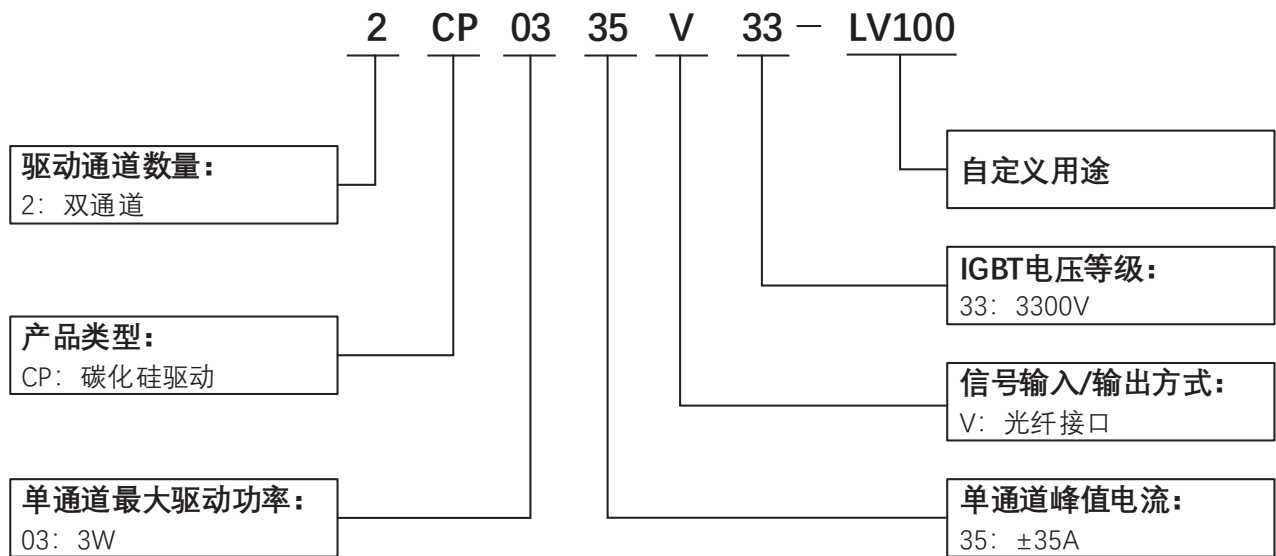
典型应用

- 风电变流器
- 光伏逆变器
- 中压变流器
- 电机传动
- 牵引传动

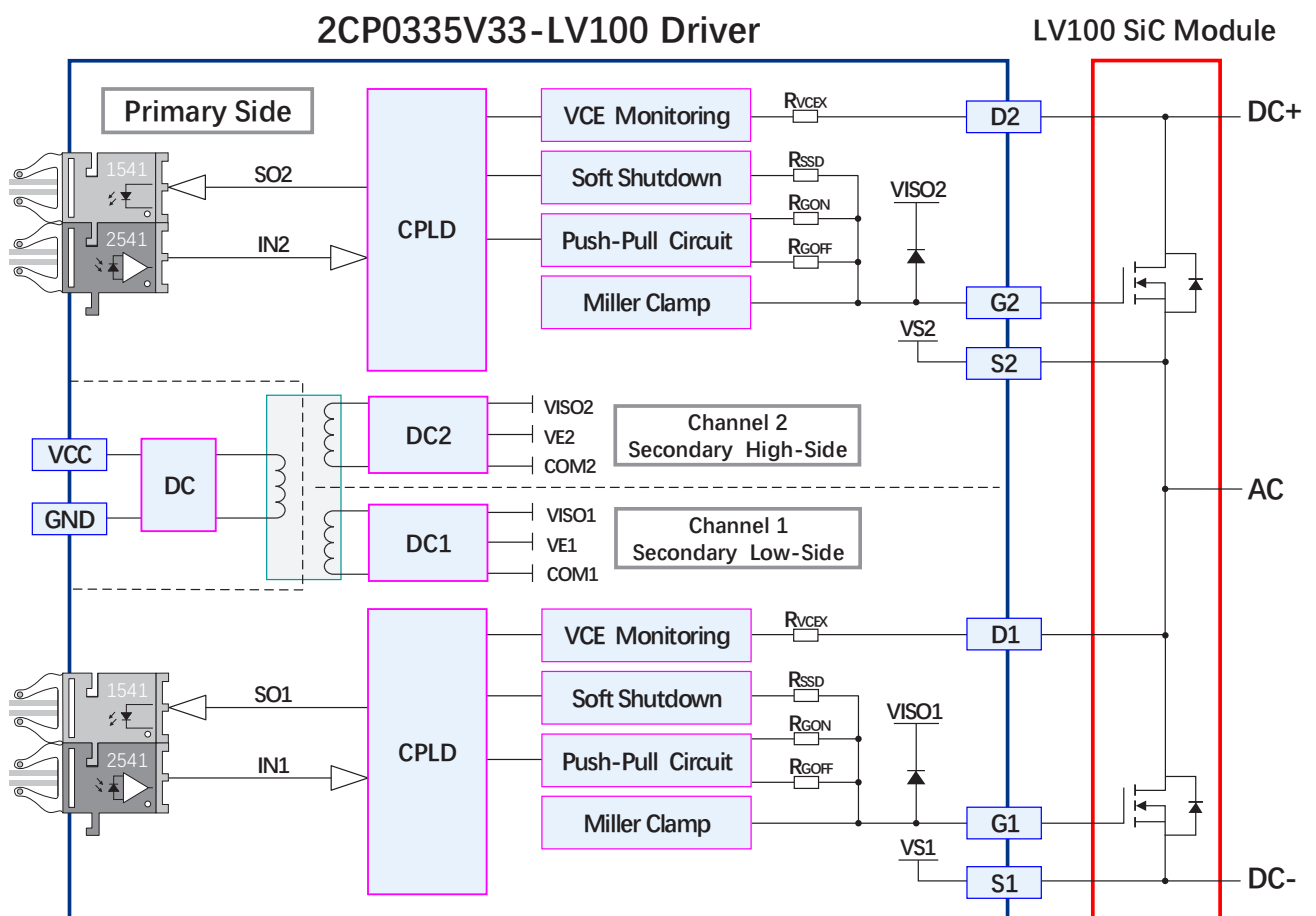
机械尺寸

机械尺寸图：参见第 10 页

型号定义



原理框图



光纤接口定义

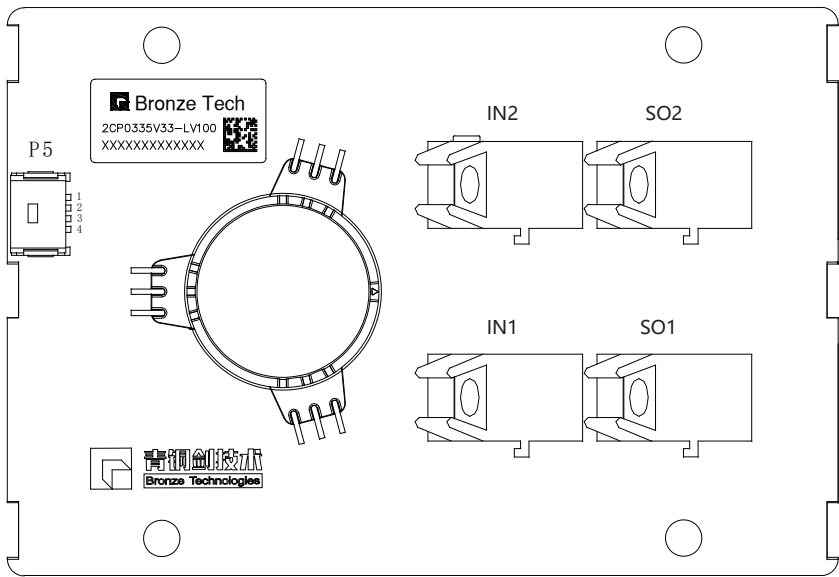
序号	符号	说明
1	IN1	下桥臂驱动信号输入端
2	SO1	下桥臂故障信号输出端
3	IN2	上桥臂驱动信号输入端
4	SO2	上桥臂故障信号输出端

注：IN1、IN2 型号：HFBR-2541ETZ。
SO1、SO2 型号：HFBR-1541ETZ。

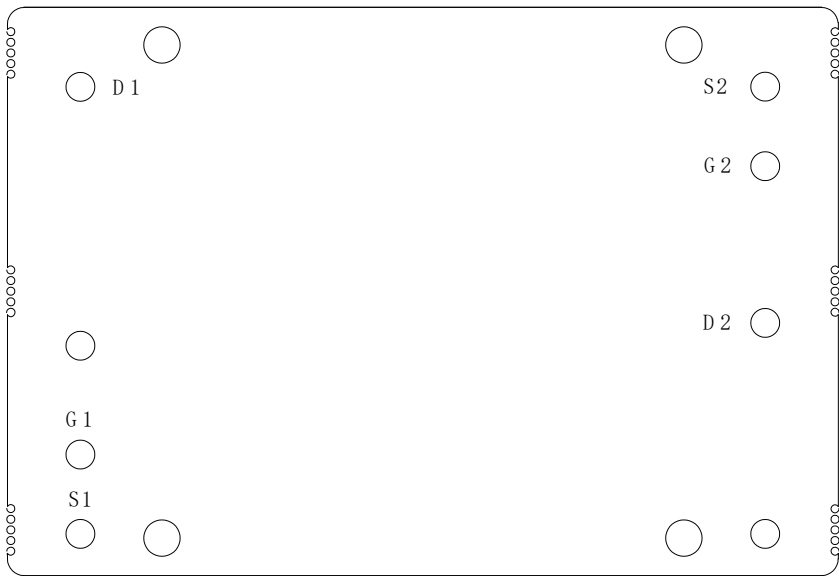
电压接口 -P5 端子定义

管脚	符号	说明
1	VCC	供电电源 +
2	VCC	供电电源 +
3	GND	信号 / 功率地
4	GND	信号 / 功率地

注：1) P5 端子型号：214012 ERNI。



2CP0335V33-LV100 主板接口示意图



2MA-LV100 门极板接口示意图

参数

绝对限值

参数	MIN	MAX	UNIT
供电电源	14	30	V
门极驱动功率 ¹⁾		3	W
门极驱动电流		35	A
母线电压		2200	V
最大开关频率		20	kHz
原 / 副边绝缘电压	8000		V
副 / 副边绝缘电压	6000		V
运行温度 T_A	-40	85	°C
存储温度 T_S	-40	85	°C
湿度 ²⁾		95	%
海拔高度 ³⁾		2000	m
注：1) 在 T_A 允许温度范围内，单通道最大输出功率。 2) 不允许出现凝露现象。 3) 超过最高海拔高度应用请咨询青铜剑技术公司。			

供电电源

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数	测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
供电电压 V_{CC}	VCC to GND	14	15	30	V
供电电流	$V_{CC}=15\text{V}$ ，空载， $f_{SW}=0\text{kHz}$		130		mA
	$V_{CC}=15\text{V}$ ，空载， $f_{SW}=10\text{kHz}$ ，50% 占空比		175		mA
	$V_{CC}=15\text{V}$ ，300nF 负载， $f_{SW}=10\text{kHz}$ ，50% 占空比		400		mA
副边全压 $V_{CCO}^{1)}$	VISO to COM	20	22	24	V
副边正压 V^+	VISO to VE	16.5	17	17.5	V
副边负压 $V^{-2)}$	COM to VE	-4	-5	-6	V
注：1) 副边全压典型值为空载测试值。 2) 副边负压典型值为空载测试值。					

输出

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
门极输出电压 V_G	开通 ON-State	$V_{CC}=15\text{V}$ ，空载	16.5	17	17.5	V
	关断 OFF-State	$V_{CC}=15\text{V}$ ，空载	-4	-5	-6	V
门极电流 I_G	开通 ON-State	$V_{CC}=15\text{V}$ ， $R_{GON}=2\Omega$ ， $R_{GOFF}=1\Omega$			11	A
	关断 OFF-State	$V_{CC}=15\text{V}$ ， $R_{GON}=2\Omega$ ， $R_{GOFF}=1\Omega$	22			A

保护

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
原边欠压保护阈值电压	触发 V_{CCUV+}	$V_{CC}=15\text{V}$ ， $V_{CC}-GND$		12.3		V
	恢复 V_{CCUVR+}	$V_{CC}=15\text{V}$ ， $V_{CC}-GND$		12.8		V
副边负压保护阈值电压 ¹⁾	触发 V_{UV-}	$V_{CC}=15\text{V}$ ， $V_{ISO}-COM$		18.2		V
	恢复 V_{UVR-}	$V_{CC}=15\text{V}$ ， $V_{ISO}-COM$		18.7		V
短路保护阈值电压 V_{REF}		$V_{CC}=15\text{V}$		10		V
短路保护响应时间 $t_{sc}^{2)}$		母线电压大于 1000V		3		us
软关断时间 t_{SOFT}		90% V_{gs} to V_E ，300nF 负载		1		us
保护锁定时间 t_B				50		ms
保护传输延时时间 $t_{so}^{3)}$	短路保护	$V_{CC}=15\text{V}$ ，副边短路保护动作到输出故障		540		ns
	副边电压欠压保护	$V_{CC}=15\text{V}$ ，副边欠压保护动作到输出故障		600		ns

注：1) 欠压保护信号输出时序图参见图 8。
 2) 采用串电阻检测方式，过流保护信号输出时序图参见图 9。
 3) 副边保护动作到原边 SO 翻转的传输延时时间。

时序

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
传输延时 ¹⁾	开通延时 t_{ON}	$V_{CC}=15\text{V}$		550		ns
	关断延时 t_{OFF}	$V_{CC}=15\text{V}$		550		ns
输出信号上升时间 t_r		$R_{GON}=2.14\Omega$ ，300nF 负载		1600		ns
输出信号下降时间 t_f		$R_{GOFF}=0.97\Omega$ ，300nF 负载		500		ns

注：1) 开通传输延时为输入光纤灯亮到门极信号上升沿 10%，关断传输延时为输入光纤灯亮到门极信号下降沿 90%。

安全和抗干扰

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数		数值	UNIT
绝缘耐压 ¹⁾	原边 - 副边	8000	V
	副边 - 副边	6000	V
原边 - 副边 ²⁾	隔离等效电容: 1kHz, 0.3V	30	pF
	电气间隙	22.8	mm
	爬电距离	22.8	mm
副边 - 副边	隔离等效电容	30	pF
	电气间隙	15	mm
	爬电距离	15	mm
ESD 静电防护	接触放电	± 4	kV
	空气放电	± 8	kV
电快速瞬变脉冲群抗扰度		± 4	kV

注：1) 测试条件为 8000V, 50Hz 交流电压, 1min。
2) 电气间隙和爬电距离, 按照 IEC 61800-5-1 标准设计。
3) EMC 测试安装 GB/T 17626 规范执行。

特性和曲线

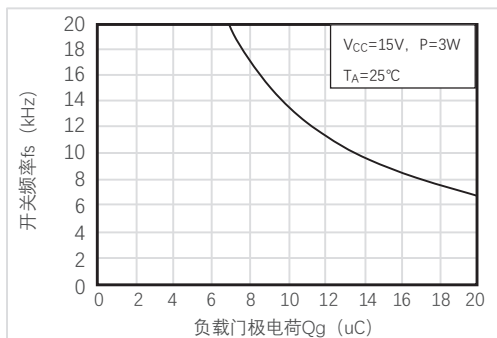


图 1 负载门极电荷 vs 开关频率

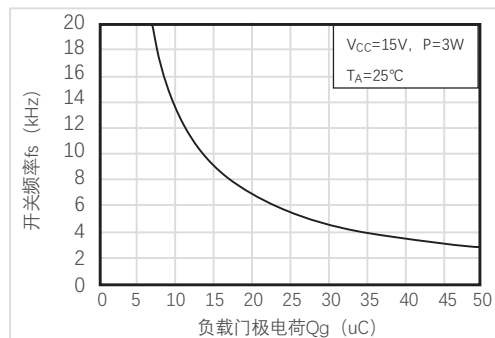


图 2 负载门极电荷 vs 开关频率

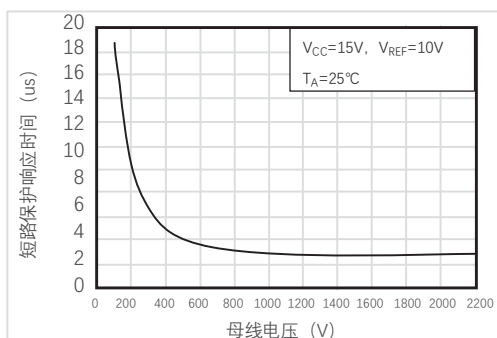


图 3 短路保护响应时间 vs 母线电压

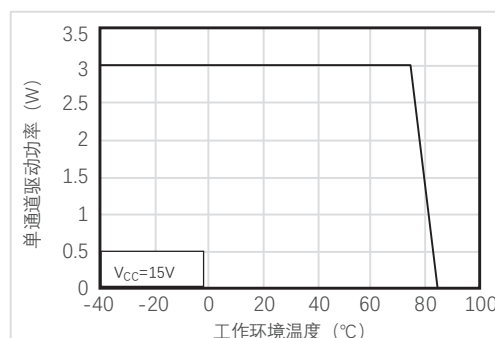


图 4 驱动功率 vs 工作温度

功能描述

电源及电源监控

这款驱动器配有隔离 DC/DC 电源，可实现电源和门极驱动电路的电气隔离，基本原理框图（如图 5 所示）。

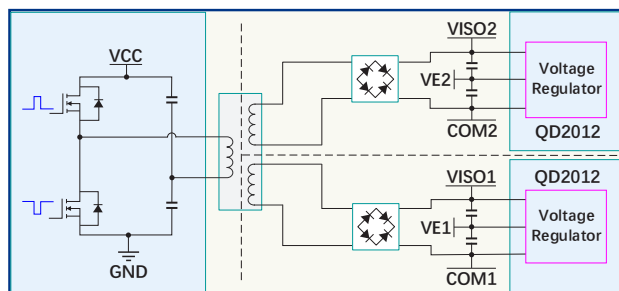


图 5 电源原理框图

驱动器的两个通道的副边都分别配备有电源监控电路，并实施欠压保护。

注意，驱动器需要稳定的供电电压！

副边电源监控

副边电压负载超载情况下，会发生电压下降。当副边电压 VISOx (VISO 至 COM) 下降至欠压保护阈值 V_{TH+} ，将启动副边欠压保护。

副边欠压保护首先会将本通道驱动锁定在关断状态，确保对应 SiC 关断。

另一通道不会受影响, 仍能正常开关, 其对应的 SO 信号为正常状态。控制系统需要及时检测 SO 信号, 并根据策略发出系统闭锁命令。

副边欠压保护逻辑关系 (参见图 6)。

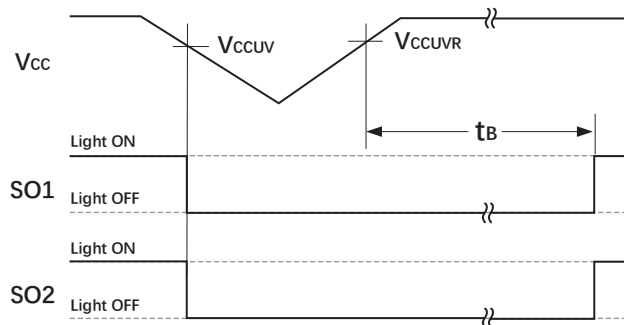


图 6 副边欠压保护逻辑图

触发信号 INx 输入

触发信号 INx 由光纤端口输入，灯亮为开通电平，灯灭为关断电平，逻辑关系（参见图 7）。

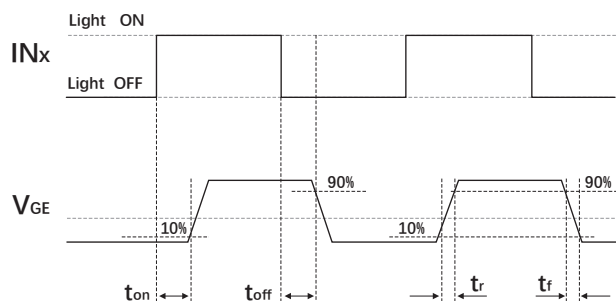


图 7 INx 输入电路图

保护信号输出

驱动器可通过光纤接口发送故障信号。光纤接口灯亮为 1, 灯灭为 0, 正常状态下故障信号为 1, 发生故障后故障信号翻转, 以信号做为起始点, 每 2us 为一位, 数据长度 8 位, 完成数据发送后以 50ms 低电平做为停止标志, 结束信号发送, 电平恢复为高电平, 逻辑关系 (参见图 8)。

故障列表见下表:

故障名称	故障编码
副边欠压故障	00100010
短路保护故障	00100000

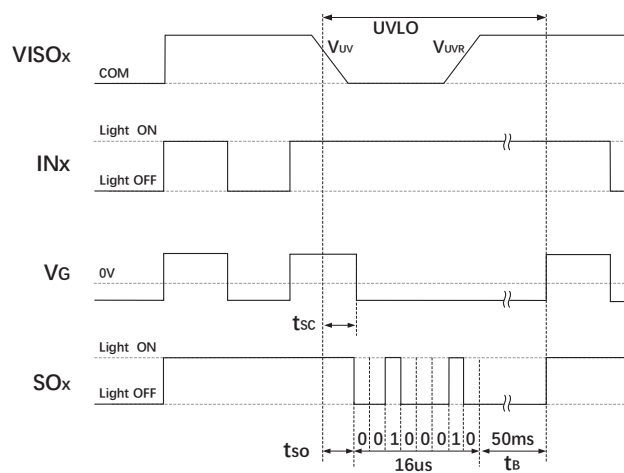


图 8 欠压保护信号输出时序图

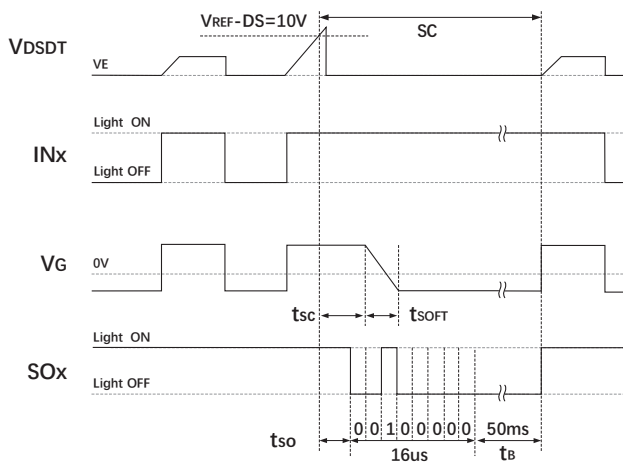


图 9 过流保护信号输出时序图

SiC 的开通和关断

驱动器的 IGBT 门极驱动电路（参见图 10）。

当需要开通 IGBT 时，驱动器内部芯片内的 QON 管打开，QOFF 管关闭，通过开通门极电阻 RGON 对 IGBT 的门极进行充电，使 IGBT 开通。驱动器外部外置推挽输出，以拓展驱动电流能力。

当需要关断 SiC 时，驱动器内部芯片内的 QOFF 管打开，QON 管关闭，通过关断门极电阻 RGOFF 对 IGBT 的门极进行放电，使 IGBT 关断。

门极电阻 RGON 和 RGOFF 的选择，用户可咨询我们技术支持来进行设置，并进行出厂预配置。在安装到对应的 IGBT 模块上时，请确保已经安装上合适的门极电阻。

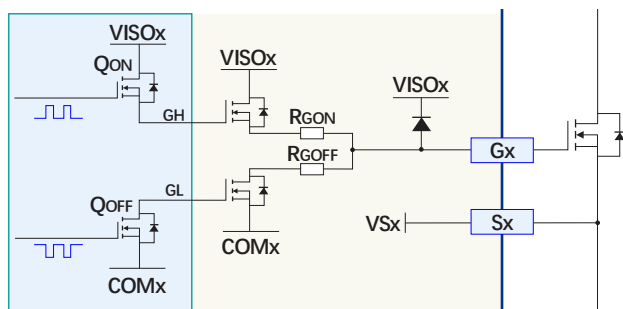


图 10 门极驱动电路图

米勒钳位

因 SiC 开通速度较快，且开通阈值电压较低，为防止在开通过程中对对桥产生的串扰问题，以防止直通情况的发生，特别设置了米勒钳位电路，在关断且门极电压低于 2V（VE to COM）时启动米勒钳位，以有效地防止栅极误开通。原理框图（参见图 11）。

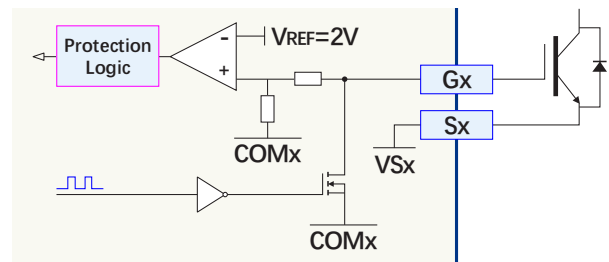


图 11 米勒钳位原理框图

SiC 短路保护

驱动器的 SiC 短路保护使用 VDS 检测电路（参见图 12），两个通道各自独立。短路保护功能只在 SiC 开通的时候有效；在 SiC 关断状态，触发信号会将 QDS 打开，使得 VDS DT 钳位在 COMx（相对 VEx 为 -10V 左右），比较器不动作。

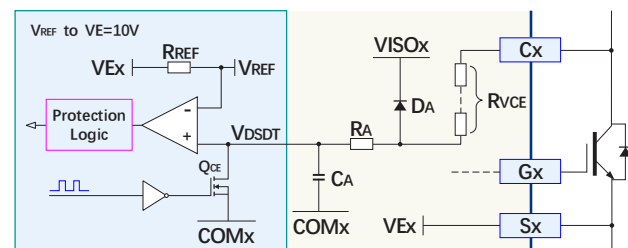


图 12 短路保护原理框图

正常开通时的表现

当驱动器执行 SiC 开通动作时，传输到副边的触发信号会将 QDS 关断，释放 VDS DT 钳位状态。此时 SiC 的 VDS 仍处于高水平，将通过 RVCE 电阻串和 RA 电阻对 CA 电容进行充电，使得 VDS DT 电平逐渐抬升。随后 SiC 开通，VDS 迅速下降至 VDS-SAT，VDS DT 也随之充电至 VDS-SAT（参见图 13）。由于 VDS-SAT 远低于保护触发值 VREF，比较器不动作，保护不启动。

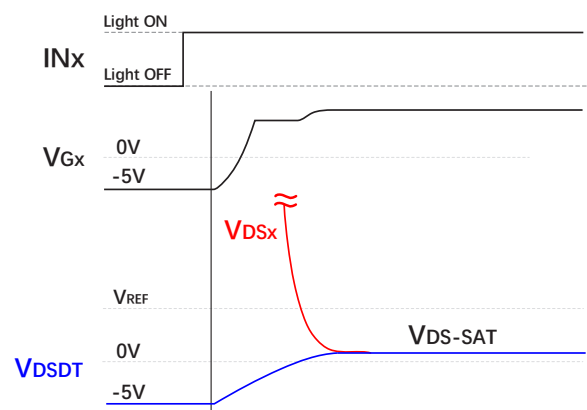


图 13 正常开通时 VDS DT 信号波形图

一类短路保护

当 SiC 发生一类短路（即直通）时，由于直通电流增长很快，SiC 将迅速退饱和， V_{DS} 很快回到高位。因此 C_A 将会一直充电，使得 V_{DSDT} 一直增长直到钳位至 V_{ISOx} 。在此过程中， V_{DSDT} 会越过 V_{REF} ，使得比较器翻转，从而启动短路保护逻辑。

短路保护逻辑会先把 SiC 迅速关断，保障 SiC 的安全。同时向原边发出信息，使得 SOx 管脚拉低，以表达出保护状态。保护状态将会锁定一个 t_B 时间，然后自动恢复到正常状态。

两个通道的保护电路是相互独立的，所以在一个通道发生短路保护的情况下，另一通道仍然能够工作在正常状态。控制系统需要及时检测 SO 信号，并根据策略发出系统闭锁命令。具体过程（参见图 14）。

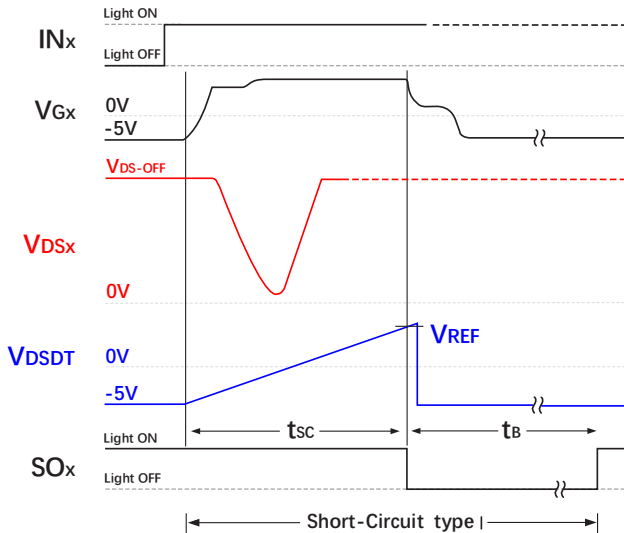


图 14 一类短路保护逻辑图

二类短路保护

当 SiC 发生二类短路（相间短路）时，由于短路回路阻抗较大，电流增长较缓慢。SiC 仍能正常进入饱和状态，然后随着短路电流的增加， V_{DS} 逐渐增加直至退饱和（参见图 15）。驱动器只有在 SiC 退饱和时才能检测出短路状态，启动短路保护。因此，二类短路保护的响应时间会比一类短路保护响应时间要更长。

当 SiC 在低母线电压下发生直通短路时，由于母线电压低导致直通电流较小，IGBT 也会呈现与二类短路保护相同的特征，相应的保护响应时间 t_{DT} 也会加长。

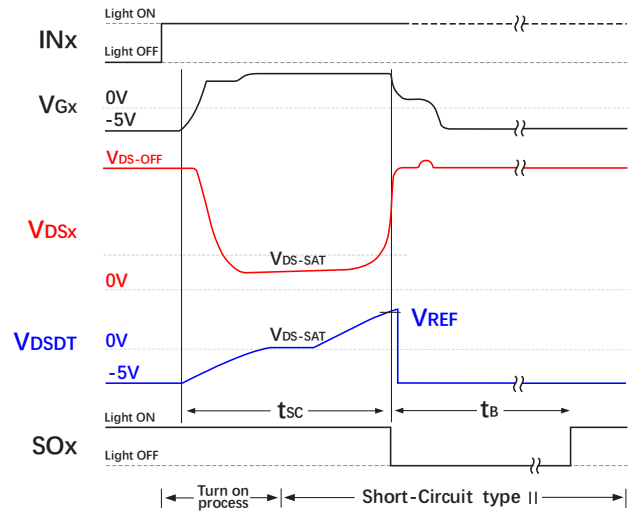


图 15 二类短路保护逻辑图

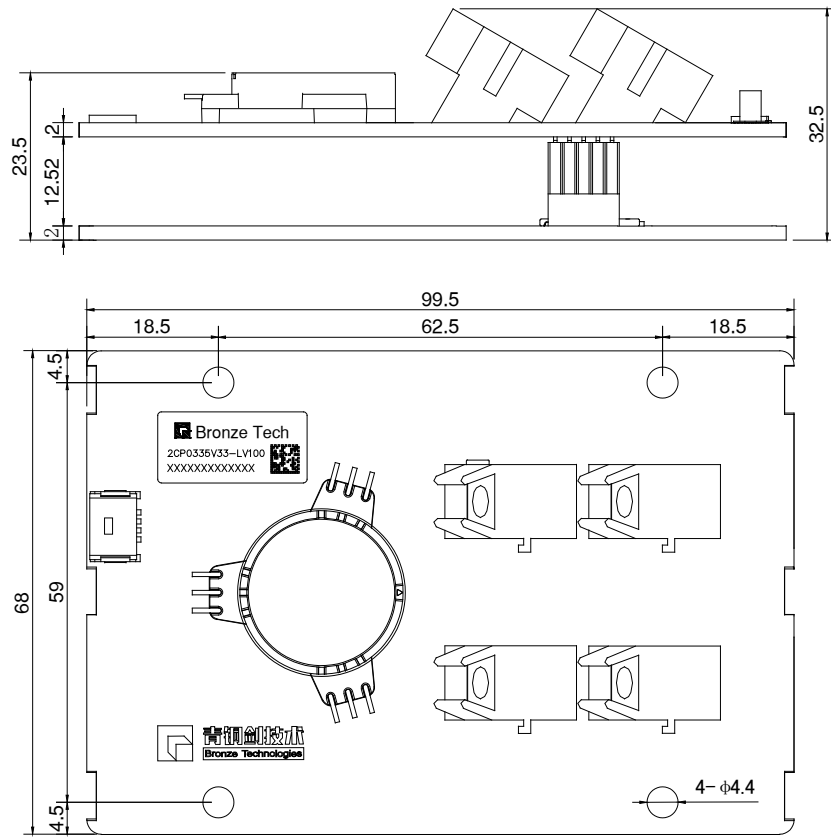
注意：二类短路时，由于短路回路阻抗随机性较大，使得 SiC 退饱和时刻不确定性较大。因此在 SiC 保护动作前，有可能已产生较大的热量损耗而导致 SiC 损坏。即，此种状态下驱动区短路保护并不能保证 SiC 不损坏，系统需辅以过流保护等其他手段，以保障 SiC 的安全。

软关断功能

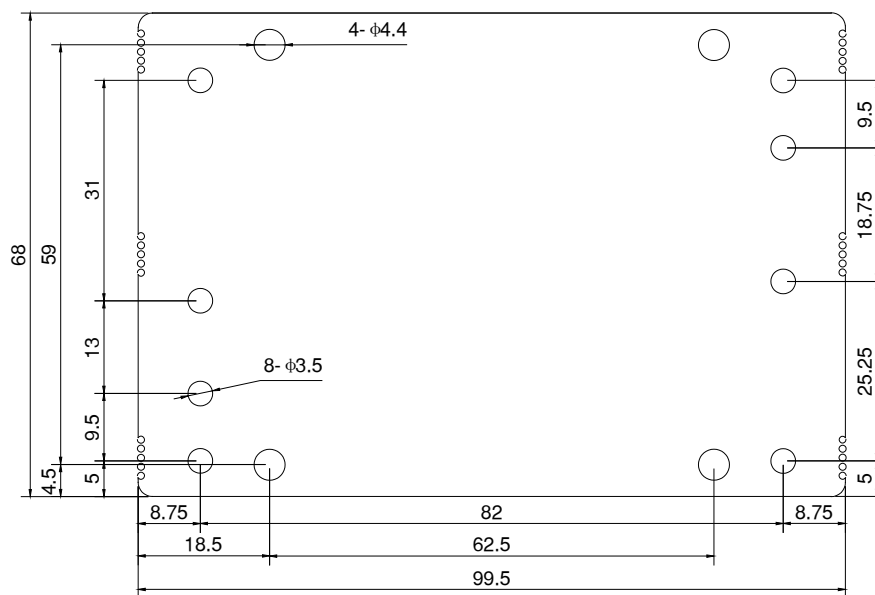
由于连接 SiC 模块的母线存在杂散电感，在 IGBT 短路保护关断时会产生较大的尖峰电压，为抑制该尖峰电压，且不影响正常关断速度，就需要加入软关断功能。

该功能在发生 SiC 短路保护时，先将驱动门极输出置为高阻状态，通过控制，使门极电压通过 R_{SOFT} 和 Q_{SOFT} 进行放电。

机械结构图



2CP0335V33-LV100 主板接口示意图



2MA-LV100 门极板接口示意图

- 注: 1) 图示单位为 mm;
2) 图中公差符合 ISO 2768-1。

版本说明

版本号	变更内容	修订日期
V1.0	新发布	02-May-2020
V1.1	说明书模板更新、内容规范化	05-Aug-2021

注意事项

- IGBT 模块和驱动器的任何操作，均需符合静电敏感设备保护的通用要求，请参考国际标准 IEC 60747-1/IX 或欧洲标准 EN100015。为保护静电感应设备，要按照规范处理 IGBT 模块和驱动器（工作场所、工具等都必须符合这些标准）。



如果忽略了静电保护要求，IGBT 和驱动器可能都会损坏！

- 驱动器上电前，请确认驱动器和控制板连接可靠，无空接、虚接、虚焊现象。
- 驱动器安装后，其表面对大地电压可能会超过安全电压，请勿徒手接触！



使用中，可能危及生命，务必遵守相关的安全规程！

免责声明

青铜剑技术提供的技术和可靠性数据（包括数据手册等）、设计资源（包括 3D 模型、结构图、AD 模型）、应用指南、应用程序或其他设计建议、工具、安全信息和资源等，不包含所有明示和暗示的保证，包括对交付、功能、特定用途、适用性保证和不侵犯第三方知识产权的保证。

这些资源旨在为使用青铜剑技术产品进行开发的熟练工程师提供。为您全权负责：

- 为您的产品选择适当的青铜剑技术产品；
- 设计、验证和测试您的产品；
- 确保您的产品符合适用的要求。

青铜剑技术保留随时修改数据、文本和资料的权力，恕不另行通知。请随时访问青铜剑技术网站 WWW.QJTJTEC.COM 或微信公众号，以获取最新的资料。

青铜剑技术授权您仅在应用青铜剑技术产品的开发过程，使用相应的资源；禁止以其他方式复制和展示这些资源。青铜剑技术没有通过这些资源，授予任何青铜剑技术的知识产权或第三方知识产权许可。

对于因您使用这些资源而引起的任何索赔、损害、损失和成本，青铜剑科技不承担任何责任，并且有权追偿因侵犯知识产权而造成的损失。



青铜剑科技集团 | 深圳青铜剑技术有限公司

地址：中国广东省 深圳市 南山区 留学生创业大厦二期 22 楼

官网：www.qjtjtec.com

电话：+86 0755 33379866

邮箱：support@qjtjtec.com



微信公众号